

# NPFセミナー

## 省エネルギー社会に貢献するGaN材料の将来と そのキープロセス技術

産業技術総合研究所ナノプロセシング施設(NPF)は、「NPFセミナー～省エネルギー社会に貢献するGaN材料の将来と、そのキープロセス技術～」を2019年3月14日(木)産業技術総合研究所臨海副都心センター別館11F会議室1(お台場)にて開催いたします。前半は、パワーデバイス応用と将来動向について、後半はデバイス作製のキープロセスとしての成膜技術、エッチング技術について紹介いたします。オーサーズ・インタビューの時間を設けましたので、講演終了後に講師の先生に個別に質問をすることが可能です。产学研官いずれのご所属の方にも奮ってのご参加をお待ちしています。

### ◇講演

【日時】平成31年3月14日(木)12:55～17:30

【場所】産業技術総合研究所臨海副都心センター別館11F会議室1(お台場)

[https://www.aist.go.jp/aist\\_j/guidemap/tokyo\\_waterfront/tokyo\\_waterfront\\_map\\_main.html](https://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tokyo_waterfront/tokyo_waterfront_map_main.html)

【参加費】無料

【定員】90名(先着順、参加登録をお願いします)

【セミナー案内/申し込み】<https://ssl.open-innovation.jp/npf/training/h30-4/index.html>

### ◇講演プログラム

12:55-13:00 はじめに

産業技術総合研究所 多田哲也

13:00-13:40 『パワーデバイスの最近の進展—GaNを中心に—』

名古屋大学未来材料・システム研究所 トヨタ先端パワーエレクトロニクス研究部門  
加地 徹

13:40-14:20 『GaN材料の特徴と省エネルギーデバイス技術への展開』

産総研GaN先進デバイスオープンイノベーションラボラトリー 清水三聰

14:20-14:50 『GaN PSJ(分極超接合)素子』

株式会社パウデック 八木修一

14:50-15:05 休憩(オーサーズインタビュー)

15:05-15:35 『GaN洗浄表面および絶縁膜/GaN界面の化学結合・欠陥準位密度評価』

名古屋大学 大学院工学研究科 大田晃生

15:35-16:05 『GaN HEMTデバイス製造におけるプラズマALD/ALEプロセスの役割』

オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 田口俊彰

16:05-16:35 『GaNデバイス材料の低ダメージエッチング技術』

スクリーンホールディングス 谷出 敦

16:35-17:05 『光電気化学反応を用いたGaNのウェットエッチングプロセス』

株式会社サイオクス 堀切文正

17:05-17:15 『ナノプロセシング施設の紹介』

産業技術総合研究所 有本 宏

17:15-17:30 休憩(オーサーズインタビュー)

### 主催:

産業技術総合研究所 ナノプロセシング施設(NPF)

### 共催

ナノエレクトロニクス計測分析技術研究会(TSC)

電子メール [tia-npf-school4@aist.go.jp](mailto:tia-npf-school4@aist.go.jp)

